

H21年1月5日

委員各位

日本学術振興会  
結晶加工と評価技術第145委員会  
委員長 田島 道夫

(独)日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第145委員会  
第116回研究会・委員総会 開催通知

日時：2009年2月3日(火) 13:00～17:50

会場：明治大学 駿河台キャンパス 大学会館 3階 第1,2会議室

[http://www.meiji.ac.jp/koho/campus\\_guide/suruga/access.html](http://www.meiji.ac.jp/koho/campus_guide/suruga/access.html)

東京都千代田区神田駿河台1-1 (TEL 03-3296-4545)

JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線/御茶ノ水駅 下車徒歩3分

東京メトロ千代田線/新御茶ノ水駅 下車徒歩5分

都営地下鉄三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線/神保町駅 下車徒歩5分

テーマ「パワーデバイス用のSiとSiC」ー低損失エネルギー制御デバイスの実現に向けてー

世話人：鹿島一日兒(コバレントマテリアル(株))、大谷昇(関西学院大学)

木本恒暢(京都大学)、伊藤久義(日本原子力研究開発機構)

プログラム

13:00～13:05 開会の挨拶

田島道夫

13:05～13:10 はじめに

鹿島一日兒

13:10～13:40 「パワーデバイス用 Si 基板開発の現状と展望」(仮題)

【依頼中】

13:40～14:10 「Si-IGBT 開発の現状と展望」(仮題)

岩室憲幸(富士電機デバイステクノロジー(株))

14:10～14:40 「中性子転換ドーピング(NTD)技術の現状と展望」(仮題)

佐川尚司(日本原子力研究開発機構)

14:40～14:55 休憩

15:00～15:30 「パワーデバイス用 SiC 結晶開発の現状と展望」(仮題)

土田秀一((財)電力中央研究所)

15:30～16:00 「SiC 結晶基板研磨技術の現状と展望」(仮題)

江龍 修(名古屋工業大学)

16:00～16:30 「SiC-パワーMOSFET 開発の現状と展望」(仮題)

中村 孝(ローム(株))

16:30～17:00 「自動車用 SiC パワーデバイス開発の現状と展望」(仮題)

谷本 智(日産自動車(株))

17:00～17:30 「SiC パワー半導体デバイスの進展」(仮題)

四戸 孝(株東芝)

17:30～17:35 おわりに

大谷 昇

17:35～17:50 委員総会

18:00～19:40 懇親会 (場所: アカデミーコモン カフェパンセ)

以上